	Поз. обозначе- ние	Наименование	Кол.	Примечание
H.		<i>Устройства</i>		
Перв. примен.	A1	VRB4812ZP-6WR3 φ. MORNSUN	1	
Перв.	A2	GeoS-5M φ. Geostar	1	
		Преобразователи неэлектрических величин		
	BL1	TEMD5510FX01	1	
	BL2	APA3010P3BT	1	
		Конденсаторы		
Cnpab. Nº	<u>C1</u>	керам., чип 0603, NPO, 50B, 1nФ ±0.1nФ	1	
ľ	<i>C2</i>	керам., чип 0603, X7R, 50B, 0.1мкФ ±10%	1	
	B	ECHU1H184GX9 ф. Panasonic (плён., чип 2416, PPS, 50B, 0.18мкФ ±2%)	1	
	<u></u>	GRM32EC81C476KE15 ф. Murata (керам., чип 1210, X6S, 16B,	1	
		47mkΦ ±10%)		
	<i>C5</i>	593D476X9016C ф. Vishay (тант., чип С, 16B, 47мкФ ±10%)	1	
	<i>C6</i>	В41858С9477М ф. EPCOS (алюм. эл-лит, рад. 18*35мм, 100B,	1	не старше 1 года
		470мкФ ±20%, низк. имп.)		
, дата	<i>C</i> 7	А755MS108M1CAAE012 ф. КЕМЕТ (алюм. полим., рад. 10*12мм, 16B,	1	
Подп. и		1000μκΦ ±20%)		
	С8	Конденсатор К58-26 – 2,7В – 100Ф (+5020)% – ЕВАЯ.673811.006ТУ	1	
J.		ф. AO «Элеконд» (ионистор, рад. 20*40мм, 2.7B, 100Ф +5020%)		
Инв. № дубл	C9-C11	керам., чип 0603, X7R, 50B, 0.1мкФ ±10%	3	
Инв	C12, C13	керам., чип 0603, X7R, 50B, 0.1мкФ ±10%	2	не устанавливать
No	C14, C15	керам., чип 0603, X7R, 50B, 0.1мкФ ±10%	2	
Взам. инв. Л	C16	керам., чип 0603, X7R, 50B, 0.1мкФ ±10%	1	не устанавливать
B3ı	<i>C17–C19</i>	керам., чип 0603, X7R, 50B, 0.1мкФ ±10%	9	
מנ	C19H	керам., чип 0603, X7R, 50B, 0.1мкФ ±10%	1	не устанавливать
Подп. и дата				
Под	Изм. Лист	N° докум. Подп. Дата	6.007	1 ПЭЗ
7	Разраб. И	ванов И.И. 2002 2025		Лит. Лист Листов
Инв. № подл	Проверил П	етров П.П. 20022025 BoM Converter отладочный проект	<i>AD</i>	1 8
Инв.	<u> </u>	703UHA В.Н. 2002 2025 Пршков А.С. 2002 2025		000 "НИИ БАЦА"

	Поз. обозначе- ние	Наименование	Кол.	Примечание
	<i>C20</i>	керам., чип 0603, X7R, 50B, 0.22мкФ ±10%	4	
	-	керам., чип 0603, X7R, 50B, 0.1мкФ ±10%	3	
	С20Н	керам., чип 0603, X7R, 50B, 0.1мкФ ±10%	1	не устанавливать
	C21A	керам., чип 0603, X7R, 50B, 0.1мкФ ±10%	1	
	C21B	керам., чип 0603, X7R, 50B, 0.068мкФ ±10%	1	
	C21C	керам., чип 0603, X7R, 50B, 0.047мкФ ±10%	1	
	C21D	керам., чип 0603, X7R, 50B, 0.033мкФ ±10%	1	
	C21E	керам., чип 0603, X7R, 50B, 0.022мкФ ±10%	1	
	C21F	керам., чип 0603, X7R, 50B, 0.015мкФ ±10%	1	
	C21H	керам., чип 0603, X7R, 50B, 0.1мкФ ±10%	1	не устанавливать
	C21G	керам., чип 0603, X7R, 50B, 0.01мкФ ±10%	1	
	<i>C22-C24</i>	керам., чип 0603, X7R, 50B, 0.1мкФ ±10%	21	
	С22Н	керам., чип 0603, X7R, 50B, 0.1мкФ ±10%	1	не устанавливать
a	С23Н	керам., чип 0603, X7R, 50B, 0.1мкФ ±10%	1	не устанавливать
Подп. и дата	С24Н	керам., чип 0603, X7R, 50B, 0.1мкФ ±10%	1	не устанавливать
Подп.				
		Микросхемы		
убл	DA1	МОСЗО6ЗМ (детектор нуля)	1	
Инв. № дубл.	DA2	TPS561201DDC φ. Texas Instruments	1	
НИ		доп. замена TPS562201DDC ф. Texas Instruments (огр. тока 2A)		
No		доп. замена TPS563201DDC ф. Texas Instruments (огр. тока 3A)		
Взам. инв.	DA3	LP5907MFX-3.3 φ. Texas Instruments	1	
Вза	DD1	SN74LVC1G126DBV φ. Texas Instruments	1	
	<i>DD2</i>	SCM3725ASA Ø. MORNSUN	1	
дата	DD3	ECS-3225MV-250-CN φ. ECS Inc. (κβαρμ., 25MΓμ ±25ppm, -40+85°C)	1	
Подп. и дата		Эломонти разнио	+	
	<i>EF1</i>	Злементы разные SMTSO-M2-2ET ф. PEM (стойка, SMD, M2*0.4, 2мм)	1	
7/1.	ER1	FK 244 13 D2 PAK φ. Fischer Elektronik	1	
Инв. № подл.		The second second of the secon		
Инв.	Max. 2	BCAD.123456	.001 /	793
Ш	Изм. Лист	№ докум. Подп. Дата		

Поз. обозначе- ние	Наименование	Кол.	Примечание
	Устройства защитные		
FP1	MF-MSMF014 φ. Bourns (camoboccm., чип 1812, 140mA, 60B)	1	
FU1	0451001. ф. Littelfuse (плавкий, чип 2410, 1A, 0.6029A ² c, быстрый)	1	
FU2	ZH242 (держатель)	1	
FU3	ZH250 (держатель)	1	
FU4	ZH242 (держатель)	1	
FU5	ZH250 (держатель)	1	
FV1	В72540T0400K062 ф. TDK (варистор, чип 2220, 68B, 9Дж)	1	
FV2	SMBJ6.5CA (супрессор, двунаправ., 6.5B, 600Bm [10/1000мкс],	1	
	корпус SMB)		
FV3	SMBJ5.0A (супрессор, однонаправ., 5B, 600Bm [10/1000мкс],	1	
	корпус SMB)		
FV4	GSOTO5C-E3-08 (cynpeccop, корпус SOT-23)	1	
FV5	CDSOT23-T24CAN ф. Bourns (супрессор, корпус SOT-23)	1	
	Генераторы, источники питания		
GB1	CR 1/2 AA S PCBD φ. VARTA	1	
GB2	BR-2325/2HAN	1	
GB3	DS1092-04-B6P ф. Connfly (держатель, , CR2032)	1	
	доп. замена ВН-25F-1 ф. Adam Tech		
	доп. замена BS-7 ф. Memory Protection Devices		
GB4	ВН-25F-1 ф. Adam Tech (держатель, , CR2032)	1	
	доп. замена DS1092-04-B6P ф. Connfly		
	доп. замена BS-7 ф. Memory Protection Devices		
	Устройства сигнальные		
HG1	CC56–12SRWA φ. Kingbright	1	
HL1	KP-1608F3C ф. Kingbright (инфракрасный, 940нм, 150град.)	1	
HL2	KPT-1608SURCK (красный, 645/630нм, 230мкд [20мА], 120град.)	1	
HL3	KPA-3010CGCK (зелёный, 574/570нм, 50мкд [20мА], 120град.)	1	
HL4	KPT-1608QBC-D (синий, 460/465нм, 100мкд [20мА], 130град.)	1	
	BCAD.123456		7Jucm
Изм. Лист	DCAD. 12.3430 № докум. Подп. Дата	כוו וטט.י	3

	Поз. обозначе- ние	Наименование	Кол.	Примечание
	HL5	KPT-1608SYCK (жёлтый, 590нм, 150мкд [20мА], 120град.)	1	
	HL6	ХРСWHT-L1-0000-008E5 ф. Cree (белый, 4000K, CRI75, 73.9лм [350мА])	1	
	HL7	SMP6-RGB ф. Bivar (многоцветный)	1	
	HL8	KPBDA-3020SURKCGKC-PF ф. Kigbright (многоцветный, сборка)	1	
	HL9	AM23ESGW ф. Kingbright (многоцветный, сборка)	1	
	J1	Перемычка чип 0402	1	
		Реле		
	K1	RZO3-1A4-DO12 φ. TE Connectivity	1	
	K2	T9GV2L24-12 φ. TE Connectivity	1	
	K3	RT214012 φ. TE Connectivity	1	
	K4	V23105A5476A201 φ. TE Connectivity	1	
		Катушки индуктивности		
	L1	чип 1812, 10мкГн ±10%, 250мА	1	
מ	<i>L2</i>	SRU1048-470Y φ. Bourns (47mkΓh ±30%, 1.5A)	1	
Подп. и дата	L3-L5	чип 1812, 10мкГн ±10%, 250мА	3	
Подп.	<u>L6</u>	SRU1048-470Y φ. Bourns (47mkΓн ±30%, 1.5A)	1	
	L7	SRU1048-470Y φ. Bourns (47ΜκΓΗ ±30%, 1.5A)	1	не устанавливать
Ση.	L8	SRU1048-470Y φ. Bourns (47mkΓн ±30%, 1.5A)	1	
Инв. № дубл.	L9, L10	SRN6045TA-2R2Y φ. Bourns (2.2mkΓh ±30%, 6A)	2	
Инв.	L11	SRR0604-100ML φ. Bourns (10mkΓh ±20%, 1.3A)	1	не устанавливать
o/	L12	SRN6045TA-2R2Y φ. Bourns (2.2mkΓh ±30%, 6A)	1	
Взам. инв. №				
Взам		Резисторы		
	R1	чип 0603, 10к0м ±5%	1	
та	R2	чип 0603, 47к0м ±0.5%, ±25ppm/°C	1	
Подп. и дата	R3	RV0805JR-071ML φ. YAGEO (чип 0805, 400B, 10κ0m ±5%)	1	
Поді	R4	чип 0603, 100к0м ±5%	1	
\perp	R5	чип 0603, 100к0м ±5%	1	не устанавливать
подл.	R6	чип 0603, 100к0м ±5%	1	
Инв. Nº подл.	Изм. Лист	ВСАД. 123456. С № докум. Подп. Дата	101 i	7.33 Aucm 4

	Поз. обозначе- ние	Наименование	Кол.	Примечание	
	R7, R8	чип 0603, 200к0м ±5%	2		
	R9, R10	чип 0603, 300к0м ±5%	2		
	R11	чип 0603, 300к0м ±5%	1	не устанавливать	
	R12	чип 0603, 300к0м ±5%	1		
	R13	чип 0603, 470к0м ±5%	1		
	R14B	чип 0603, 2к0м ±1%	1		
	R14C	чип 0603, 3к0м ±1%	1		
	R14A	чип 0603, 1к0м ±1%	1		
	R14D	чип 0603, 4.3к0м ±1%	1		
	R14 G	чип 0603, 7.5к0м ±1%	1		
	R14F	чип 0603, 6.2к0м ±1%	1		
	R14E	чип 0603, 5.1кОм ±1%	1		
	R14H	чип 0603, 1к0м ±1%	1	не устанавливать	
	R15D	чип 0603, 4.3кОм ±1%	1		
	R15C	чип 0603, 3к0м ±1%	1		
Подп. и дата	R15B	чип 0603, 2к0м ±1%	1		
Тодп. ц	R15A	чип 0603, 1к0м ±1%	1		
	R15E	чип 0603, 5.1кОм ±1%	1		
72.	R15F	чип 0603, 6.2к0м ±1%	1		
Инв. № дубл.	R15G	чип 0603, 7.5к0м ±1%	1		
Инв.	R15H	чип 0603, 1к0м ±1%	1	не устанавливать	
0					
Взам. инв. №	R16C	чип 0603, 3к0м ±1%	1		
Взам.	R16F	чип 0603, 6.2к0м ±1%	1		
	R16D	чип 0603, 4.3к0м ±1%	1		
Подп. и дата	R16G	чип 0603, 7.5к0м ±1%	1		
	R16H	чип 0603, 1к0м ±1%	1	не устанавливать	
	R16E	чип 0603, 5.1кОм ±1%	1		
	R16A	чип 0603, 1к0м ±1%	1		
одл.	R16B	чип 0603, 2к0м ±1%	1		
Инв. № подл.		DCAD 422/5/	001	ПЭЭ	Лист
MH.	Изм. Лист	ВСАД. 123456. № докум. Подп. Дата	<i>UU1 1</i>	כבו <i>י</i>	5

	Поз. обозначе- ние	Наименование	Кол.	Примечание	
	R17A	чип 0603, 1к0м ±1%	1		
	R17B	чип 0603, 2к0м ±1%	1		
	R17C	чип 0603, 3к0м ±1%	1		
	R17D	чип 0603, 4.3к0м ±1%	1		
	R17E	чип 0603, 5.1к0м ±1%	1		
	R17F	чип 0603, 6.2к0м ±1%	1		
	R17G	чип 0603, 7.5к0м ±1%	1		
	R17H	чип 0603, 1к0м ±1%	1	не устанавливать	
	R18A	чип 0603, 1к0м ±1%	1		
	R18B	чип 0603, 2к0м ±1%	1		
	R18C	чип 0603, ЗкОм ±1%	1		
	R18D	чип 0603, 4.3к0м ±1%	1		
	R18E	чип 0603, 5.1к0м ±1%	1		
	R18G	чип 0603, 7.5к0м ±1%	1		
	R18F	чип 0603, 6.2к0м ±1%	1		
Подп. и дата	R18H	чип 0603, 1к0м ±1%	1	не устанавливать	
Тодп. и					
	R19B	чип 0603, 2к0м ±1%	1		
	R19C	чип 0603, ЗкОм ±1%	1		
Инв. № дубл.	R19E	чип 0603, 5.1к0м ±1%	1		
Инв. 1	R19F	чип 0603, 6.2к0м ±1%	1		
	R19G	чип 0603, 7.5к0м ±1%	1		
инв. №	R19A	чип 0603, 1к0м ±1%	1		
Взам. инв.	R19H	чип 0603, 1к0м ±1%	1	не устанавливать	
	R19D	чип 0603, 4.3к0м ±1%	1		
שנו					
Подп. и дата	RK1	NCP18XQ102J03RB φ. Murata (чип 0603, 1κ0m ±5%)	1		
Подп	RK2	TFPT0805L1000FV φ. Vishay (чип 0805, 1000м ±1%)	1		
	RP1	3006P-1-103 ф. Bourns (10к0м ±10%, , подстроечный, лин. хар-ка)	1		
эдл.					
Инв. № подл.		DCAD 403 / E/	004	 П Э Э	Лист
NHC	Изм. Лист		UU'I I	ללו'	6

	Поз. обозначе- ние	- Наименование	Кол.	Примечание
		Устройства коммутационные		
	SA1	CHS-01TA ф. Copal Electronics Inc.	1	
	SA2	SWD-08L	1	
	SA3	MS-22D18 (движковый)	1	
	SA4	GPTS203211B φ. CW Industries	1	
	SA5	SSSF012100	1	
	SA6	PN12SHNAO3QE φ. C&K	1	
	SB1	DTSM-61N ф. Diptronics (кнопочный)	1	
	<i>T1</i>	Трансформатор HX1188NL ф. Pulse	1	
		Диоды		
	VD1	BAS316 (100B, 250mA, корпус SOD-323)	1	
	VD2	BAT20JFILM (Шоттки, 23B, 1A, корпус SOD-323)	1	
	VD3	BZT52H-B13 (13B ±2%, 830мВт, корпус SOD-123F)	1	
	VD4	BB545E7904 φ. Infineon	1	
и дата	VD5	BAT54AFILM (Шоттки, 40B, 300мA, корпус SOT-23)	1	
Подп. и	VD6	BAT54CFILM (Шоттки, 40B, 300мA, корпус SOT-23)	1	
П	VD7	BAT54SFILM (Шоттки, 40B, 300мА, корпус SOT-23)	1	
Эубл.		Tupucmanu		
Инв. № дубл.	VS1	Тиристоры	1	
Ż	VS2	TVN/ 12DG & STMicroplectropics // OOP 124 15wA	1	
. No	VS3	TYN412RG φ. STMicroelectronics (400B, 12A, 15mA)	1	
Взам. инв.	VS4	ТММDB3TG ф. STMicroelectronics (двунаправ., 32B, 2A, 15мкА) BTA24-600BWRG	1	
7	_			
та		Транзисторы		
Подп. и дата	VT1	ВСR108 (биполярный цифровой)	1	
Поді	VT2	IRLML2030	1	
	VT3	BC817	1	
оди.	VT4	ВСR158 (биполярный цифровой)	1	
Инв. № подл.		BCAD.12345		Лист
4	Изм. Лист	№ докум. Подп. Дата	כוו וטט.טי	7

	Поз. обозначе- ние	Наименование	Кол.	Примечание	
	VT5	IRLML5103	1		
	VT6	BC807	1		
	VU1	Onmonapa LTV-357T	1		
		Соединители			
	X1	15EDGRC-3.5-04Р ф. Degson	1		
	X2	5035000993 φ. Molex	1		
	712	доп. замена 5035000991	'		
	X3	292303-1 φ. TE Connectivity	1		
		Фильтры			
	ZC1	WCM4532F2SF-142T2O-HI φ. TAI-TECH Advanced Electronics Co., Ltd.	1		
		(синф. дроссель, 1.4кОм [100МГц], 100мОм, 2А)			
	ZF1	MMZ1608B102C φ. TDK (φep. δyc., чип 0603, 1κ0м ±25% [100MΓц],	1		
		600m0m, 300mA)			
a	ZQ1	FY0800018 ф. Diodes Incorporated (кварц., 8МГц ±30ррт, фунд., 18пФ,	1		
и дата		1000м, -40+85°С)			
Подп. и	ZQ2	ABS07-32.768КHZ-Т ф. Abracon (кварц., 32.768кГц ±20ррт, 12.5пФ,	1		
	_	70кОм, -40+85°С)			
, дубл.		Сопутствующие элементы			
Инв. № дубл.		Батарея CR2032 (3B, 225мАч)	2	для GB3, GB4	
		Предохранитель 0215002.MXP ф. Littlefuse (плавкий, цил. 5*20, 2A,	1	для FU3	
HB. Nº		11.68А ² с, 250В, медленный)			
Взам. инв. №		Предохранитель 520.517 ф. ESKA Erich Schweizer (плавкий, цил. 5*20,	4	для FU2, FU4; один за	пасной
7		1A, O.2A ² c, 25OB, быстрый)			
מנ		Предохранитель 520.517 ф. ESKA Erich Schweizer (плавкий, цил. 5*20,	1	для FU5	
Подп. и дата		1A, O.2A ² c, 25OB, быстрый)			
Подп		Радиатор FK 231 SA 220 ф. Fischer Elektronik (T0220, 24K/Bm)	1	для VS4	
		Соединитель 15EDGK-3.5-04P-14 ф. Degson	1	для X1	
подл.					•
Инв. № подл.		BCAD.123456.C	<u> </u>	773	Лист
1	Изм. Лист	№ докум. Подп. Дата			8